

2SB750, 2SB750A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形ダーリントン
Si PNP Epitaxial Planar Darlington

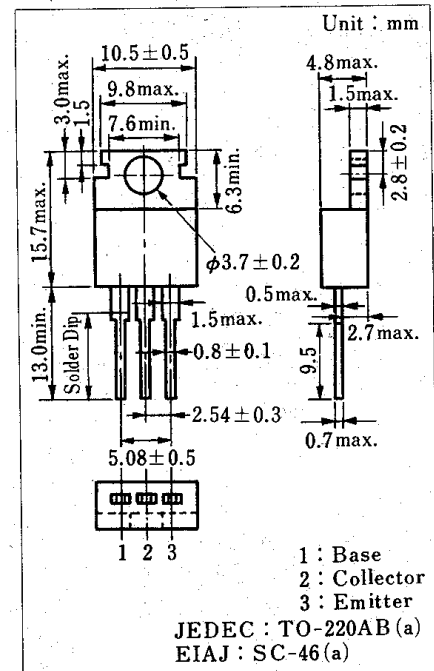
電力増幅用, スイッチング用 / Power Amplifier, Switching
2SD836, 2SD836A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SD836, 2SD836A

■ 特 徴 / Features

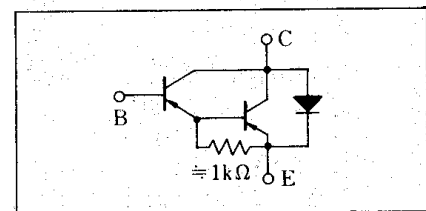
- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。/ High h_{FE}
- スイッチング速度が速い。/ High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item		Symbol	Value	Unit
コレクタ・ ベース電圧	2SB750	V_{CBO}	-60	V
	2SB750A		-80	
コレクタ・ エミッタ電圧	2SB750	V_{CEO}	-60	V
	2SB750A		-80	
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流		I_{CP}	-4	A
コレクタ電流		I_C	-2	A
コレクタ損失 ($T_c=25^{\circ}C$)		P_C	35	W
接合部温度		T_j	150	$^{\circ}C$
保存温度		T_{stg}	-55~+150	$^{\circ}C$



内部接続図/Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (T_c=25°C)

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	2SB750	I_{CBO}	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$			-1	mA
	2SB750A		$V_{CB} = -80V, I_E = 0$			-1	
コレクタ しゃ断電流	2SB750	I_{CEO}	$V_{CB} = -30V, I_B = 0$			-2	mA
	2SB750A		$V_{CB} = -40V, I_B = 0$			-2	
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$			-2	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SB750	V_{CEO}	$I_C = -30mA, I_B = 0$	-60			V
	2SB750A		$I_C = -30mA, I_B = 0$	-80			V
直流電流増幅率		h_{FE1}	$V_{CE} = -4V, I_C = -1A$	1000			
		h_{FE2}^*	$V_{CE} = -4V, I_C = -2A$	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	$V_{CE} = -4V, I_C = -2A$			-2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2A, I_B = -8mA$			-2.5	V
ターンオン時間		t_{on}	$I_C = -2A, I_{B1} = -8mA, I_{B2} = 8mA$		0.2		μs
ターンオフ時間		t_{off}			2		μs

*h_{FE2} ランク分類/h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h _{FE2}	1000~2500	2000~5000	4000~10000